FMJ65R1K0

N 沟道超级结功率 MOSFET

概述

该系列 MOSFET 采用最新一代的超结工艺，并对各项参数进行优化设计，使产品兼具低导通阻抗和低门极电荷，满足消费类和工业类开关电源的技术要求，广泛应用于反激，正激，PFC，LLC 等电路拓扑。

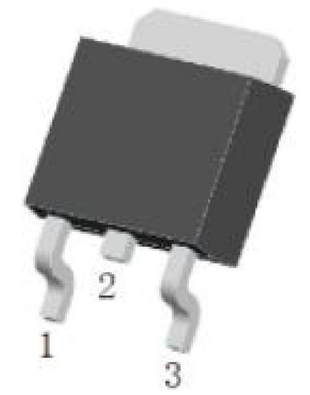
产品特征

- 最新的高压超结技术；
- 低导通电阻，低导通损耗；
- 多种封装可选；
- 超低门电荷降低驱动要求；
- 100%雪崩测试；
- 通过无铅认证

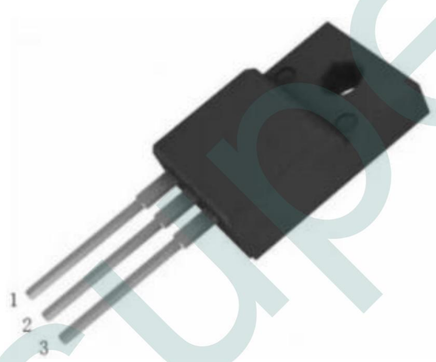
应用领域

- 功率因数校正(PFC)；
- 开关电源(SMPS)；
- 充电器(Charger)；
- LED 驱动电源(LED Driver)。

引脚示意图及说明



TO-252

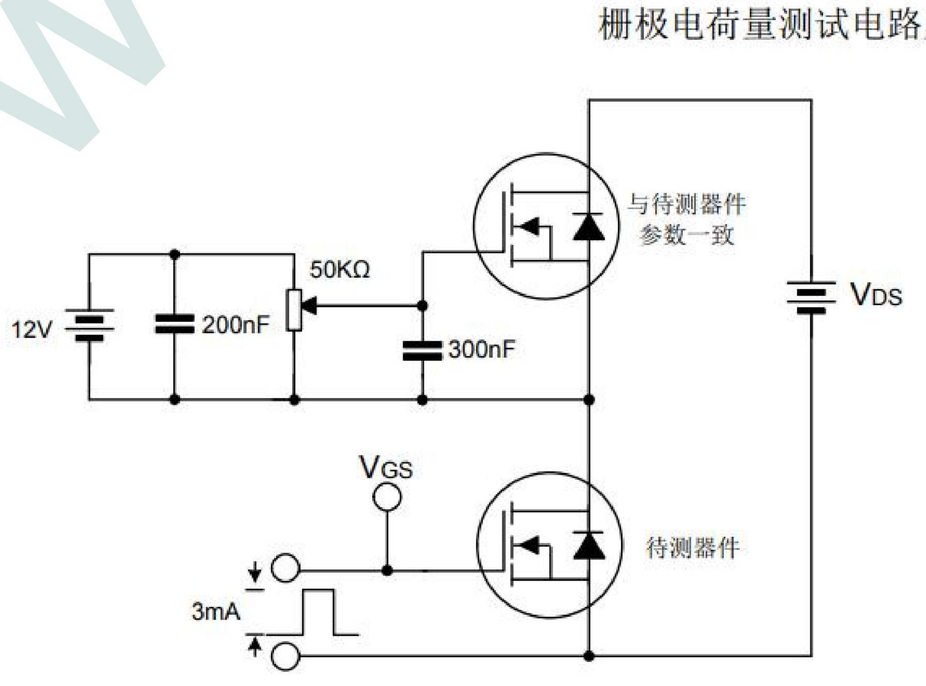


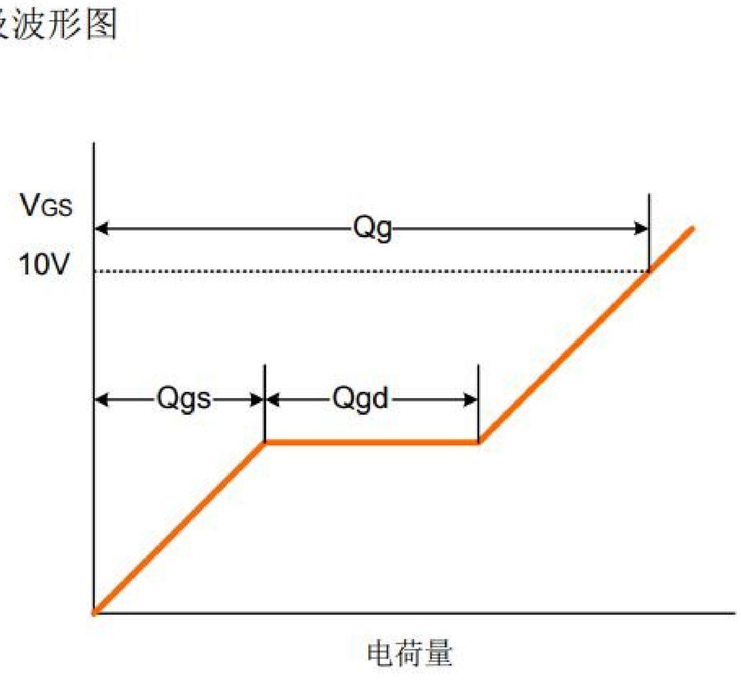
TO-220F

TO-252/TO-220F	
引脚号	**名称**
1	栅极
2	漏极
3	源极

典型应用

栅极电荷量测试电路及波形图





www.superchip.cn